

# IGBT МОДУЛИ

20-летний опыт  
разработки и производства  
IGBT модулей

для преобразователей  
средней мощности

- ♦ Ток 50 ÷ 600 А
- ♦ Напряжение 600, 1200, 1700, 3300 В
- ♦ Частота коммутации до 50 кГц
- ♦ Полумосты, чопперы, одиночные ключи,  
ключи с общим эмиттером



- ♦ Адаптированы к российским климатическим условиям
- ♦ Корпуса с повышенной прочностью (одиночные удары до 500g)
- ♦ Основания из меди или композиционного материала AlSiC
- ♦ Повышенная энерготермоциклостойкость
- ♦ Комплектные поставки с драйверами и охладителями

Технология IGBT	600 В		1200 В				1700 В		3300 В
	NPT Low Loss	Trench Gate III	Trench Gate IV	NPT Standard	NPT Ultra Fast	Гибридные NPT Ultra Fast + SiC диоды Шоттки	Trench Gate	NPT Low Loss	NPT Field Stop
Оптимальная частота коммутации, кГц	2 ÷ 20	1 ÷ 5	2 ÷ 8	4 ÷ 12	12 ÷ 25	25 ÷ 50	2 ÷ 5	1 ÷ 2	0.5 ÷ 1



**ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ**  
www.elvpr.ru